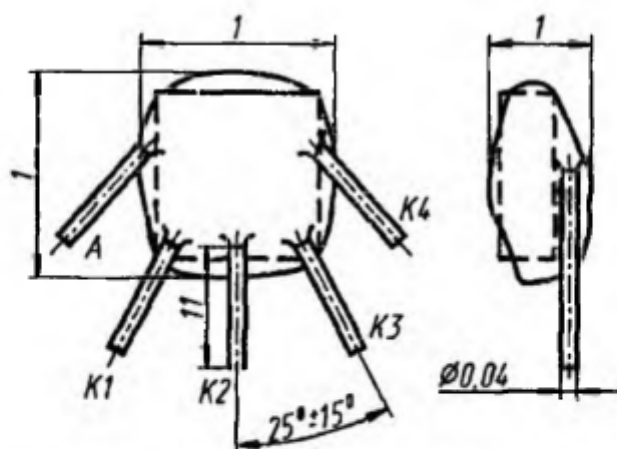


**2Д904А-1, 2Д904Б-1, 2Д904В-1,
2Д904Г-1, 2Д904Д-1, 2Д904Е-1,
КД904А-1, КД904Б-1, КД904В-1,
КД904Г-1, КД904Д-1, КД904Е-1**

Диодные матрицы, состоящие из одного (2Д904А-1, КД904А-1), двух (2Д904Б-1, КД904Б-1), трех (2Д904В-1, КД904В-1), четырех (2Д904Г-1, 2Д904Е-1, КД904Г-1, КД904Е-1) кремниевых, планарных диодов, с общим анодом. Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре. Бескорпусные, с гибкими выводами. Тип прибора и схема соединения электродов с выводами приводятся на индивидуальной таре.

Масса матрицы не более 0,01 г.

2Д904(А-1-Д-1), КД904(А-1-Е-1)



2Д904А-1

2Д904Б-1

2Д904В-1, Д-1

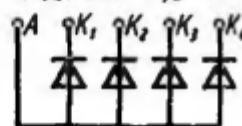
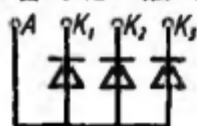
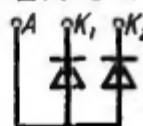
2Д904Г-1, Е-1

КД904А-1

КД904Б-1

КД904В-1, Д-1

КД904Г-1, Е-1



Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение:

при $I_{пр} = 0,01$ мА, не менее:

$T = +25$ °С 0,45 В

$T = +85$ °С 0,31 В

при $I_{пр} = 1$ мА, не более:

$T = +25$ °С 0,8 В

$T = -60$ °С 1,05 В

Разность прямых напряжений двух диодов

из числа первых трех диодов при

$I_{пр} = 0,05 \dots 0,5$ мА для 2Д904Д-1, 2Д904Е-1, КД904Д-1, КД904Е-1, не более 10 мВ

Постоянный обратный ток при $U_{обр} = 10$ В,

не более:

$T = +25$ °С 0,2 мкА

$T = +85$ °С 1 мкА

Время обратного восстановления при
 $U_{\text{ОБР, и}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{пр, и}} = 5 \text{ мА}$, $I_{\text{ОБР}} = 1 \text{ мА}$,
 не более 10 нс
 Общая емкость каждого диода при
 $U_{\text{ОБР}} = 0,1 \text{ В}$, $f = 1 \dots 10 \text{ МГц}$, не более 2 пФ

Предельные эксплуатационные данные

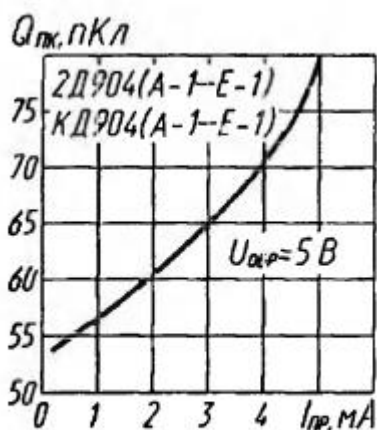
Постоянное обратное напряжение 10 В
 Импульсное обратное напряжение
 при $t_{\text{и}} \leq 2 \text{ мкс}$, $Q \geq 10$ 12 В
 Суммарный выпрямленный ток (суммарный
 ток всех диодов матрицы) 5 мА
 Импульсный прямой ток при $t_{\text{и}} \leq 10 \text{ мкс}$,
 $I_{\text{пр, ср}} \leq 5 \text{ мА}$ 100 мА
 Температура окружающей среды $-60 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$

Изгиб выводов допускается не ближе 0,3 мм от защитного покрытия. Не допускается соприкосновение выводов с кристаллом и перегиб выводов на инструменте с острыми краями.

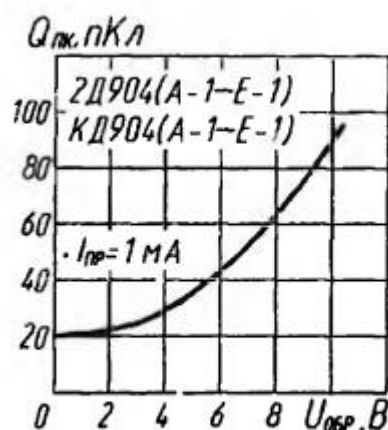
Пайка (сварка) выводов допускается не ближе 2 и не далее 7 мм от защитного покрытия. Нагрев кристалла и защитного покрытия при пайке (сварке) не должен превышать $+85 \text{ }^\circ\text{C}$.

При включении матриц в измерительную или испытательную схему, находящуюся под напряжением, общий вывод (катод) должен присоединяться первым и отключаться последним.

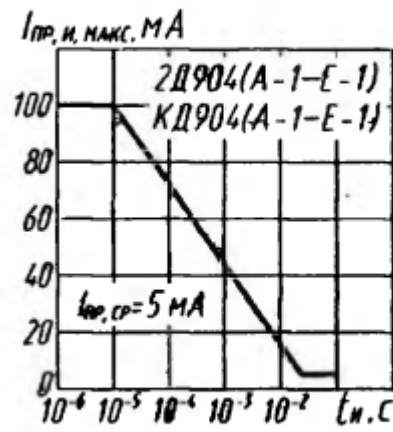
Защитное покрытие матриц изготовлено из эмали ЭП-91.



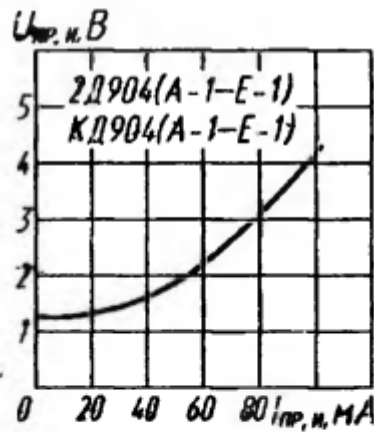
Зависимость заряда переключения от тока



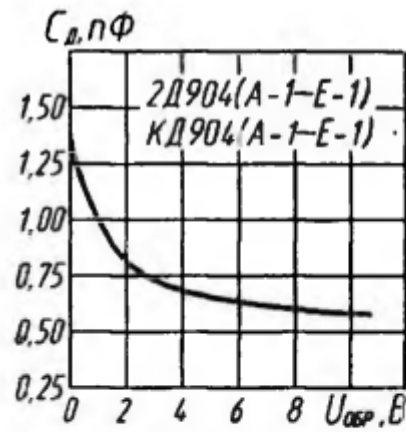
Зависимость заряда переключения от напряжения



Зависимость допустимого импульсного прямого тока от длительности импульса



Зависимость импульсного прямого напряжения от импульсного прямого тока прямоугольной формы с временем нарастания фронта 2...3 нс



Зависимость общей емкости диода от напряжения